

УДК 535.376 : 548.0

ТЕРМОСТИМУЛИРОВАННАЯ ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ФОСФОРОВ НА ОСНОВЕ КЖ

Л. П. Смольская, И. А. Парфянович и Е. И. Шуралеева

Исследовалась термостимулированная люминесценция кристаллов КЖ с примесями Na^+ , OH^- , Cu^+ и Tl^+ , облученных рентгеновскими лучами при 90 — 270°K . Установлен знак пики термолюминесценции и проведено сопоставление максимумов термоизлучения с разрушением соответствующих электронных или дырочных центров захвата основного вещества или примесных ионов.

Несмотря на то что метод термовысвечивания давно используется для исследования электронных и дырочных ловушек вЩГК, термостимулированная люминесценция фосфоров на основе КЖ изучена явно недостаточно. Так, в работах [1, 2] приводятся данные о запасании светосуммы «чистыми» КЖ, облученными рентгеновскими лучами при 77°K . Авторами [2] сделана попытка различить пики термолюминесценции, обусловленные освобождением электронов и дырок с уровней захвата. Природа уровней захвата в этих работах не обсуждается. Наиболее подробно изучена термостимулированная люминесценция фосфора КЖ-Тl [3, 4].

Целью настоящей работы являлось установление природы пики термолюминесценции (ТЛ) и выяснение знака и механизма рекомбинационных процессов в кристаллах КЖ с различными примесями в интервале температур 90 — 400°K .

Исследовались «чистые» кристаллы КЖ и с добавками Na^+ , OH^- , Cu^+ и Tl^+ , выращенные из расплава по методу Стокбаргера (Стокб.) и по методу Киропулоса (Кироп.). Анализы образцов показали, что они содержат некоторое количество чужеродных примесей; эти данные для неактивированных кристаллов суммированы в табл. 1.

Таблица 1

Кристалл	Примесь					
	Na^+ , мол. %	OH^- , мол. %	CO_3^{2-} , мол. %	Cu^+ , мол. %	Ca^{2+} , Rb^+ , Cs^+ , Tl^+ , мол. %	NO_3^- , $\times \text{mm}^{-1}$ полосы 1380 cm^{-1}
КЖ (Стокб., Иркутск)	$(1\text{--}5)\cdot10^{-2}$	Не обна- ружено	Не обна- ружено	$<5\cdot10^{-4}$	$<1\cdot10^{-4}$	0—0.010
КЖ (Зонная плавка, Рига)	$<5\cdot10^{-3}$	$\sim 7\cdot10^{-3}$	Не обна- ружено	$<1\cdot10^{-4}$	$<1\cdot10^{-4}$	Не обна- ружено
КЖ (Кироп., Рига)	$\sim 1\cdot10^{-2}$	$\sim 1.5\cdot10^{-2}$	$\sim 1\cdot10^{-4}$	Не извест- но	Не извест- но	0.029

Количество натрия в кристаллах определялось методом пламенной спектрофотометрии, таллия — полярографическим методом, ионов Cu^+ , Ca^+ , Rb^+ и Cs^+ — методом абсорбционной спектроскопии. Для определе-

ния концентрации кислородосодержащих анионов использовалась формула [5]

$$C, \text{ мол. \%} = \frac{k\chi \text{ см}^{-1}}{a^3 \text{ \AA}},$$

где χ — коэффициент поглощения в максимуме полосы поглощения и a — постоянная решетки. Коэффициент k равен 10 для ионов OH^- (3600 см^{-1}) и 0.09 для ионов CO_3^{2-} (1430 см^{-1}) [5]. Поскольку величина k для ионов NO_3^- (1380 см^{-1}) нам не известна, в табл. 1 приведено лишь значение χ в максимуме полосы поглощения 1380 см^{-1} .

Возбуждение производилось рентгеновскими лучами при $90-270^\circ \text{ K}$ (50 кв, 20 ма, W-антикатод, расстояние от образца до антикатода 7 см). В процессе равномерного нагрева кристаллов со скоростью $\beta=0.15$ град./сек. автоматически записывались интенсивность интегральной ТЛ и ее спектральный состав. Температуры максимумов ТЛ исследуемых кристаллов приведены в табл. 2.

Спектры ТЛ в области низких температур в кристаллах КJ, КJ-OH и КJ-Na состоят в основном из двух полос с $\lambda_m=375 \text{ nm}$ и $\lambda_m=430 \text{ nm}$, причем в пике ТЛ при 98° K преобладает ультрафиолетовое излучение, а в пиках ТЛ при 115 и 154° K — синее. Появление этих полос свечения обусловлено рекомбинацией освобожденных изловушек электронов с автолокализованными дырками $-v_{k^-}$ и v_{ka^-} -центрами. Помимо указанных полос в спектрах рентгенолюминесценции (РЛ) присутствует более слабая α -люминесценция с $\lambda_m=540 \text{ nm}$ [6]. Спектры ТЛ и РЛ кристаллов КJ-Cu и КJ-Tl с малым содержанием активатора при $90-170^\circ \text{ K}$ подобны спектру «чистого» КJ. В образцах с содержанием таллия более $2 \cdot 10^{-2}$ мол. % преобла-

Таблица 2

Кристаллы	Положение максимумов ТЛ, $^\circ \text{K}$						$T_g, ^\circ \text{K}$ рентгенизации
	98	98	98	98	98	98	
KJ (Стокб.)	145	154	154	154	190	190	90
KJ (Кирол.)	115	154	154	154	190	190	90
KJ-Na (0.43 мол. % Na ⁺ , Стокб.)	115	145	154	190	—	—	90, 130
KJ-Na (1 мол. % Na ⁺ , Кирол.)	115	145	154	154	—	—	90
KJ (зонная плавка)	145	145	154	154	—	—	90
KJ-KOH (1 вес.-% KOH, Кирол.)	115	145	154	190	205	230	90
KJ-Cu ($4 \cdot 10^{-3}$ мол.-% Cu ⁺ , Стокб.)	110	110	145	154	175	240	360
KJ-Tl (0.06 мол.-% Tl ⁺ , Кирол.)	110	110	145	154	175	240	360
KJ-Tl (0.01 мол.-% Tl ⁺ , Стокб.)	110	—	—	—	—	—	90, 130, 270
Энергия активации, эВ	0.25	0.285	0.27	0.35	0.31	0.39	0.98
Знак и природа пиков	—	v_k^+	—	F'	Tl°	Tl_2^+	$V_2 + F$

дает активаторная люминесценция. Выше 170° К, когда излучение решетки и излучение, обусловленное примесью натрия, термически погашены, в спектрах ТЛ и РЛ кристаллов наблюдается α -люминесценция в КJ, KJ-Na и KJ-OH и активаторная вместе с α -люминесценцией в KJ-Tl и KJ-Cu.

Было обнаружено, что увеличение добавок KOH в KJ от 0.01 до 0.5 вес.% приводит к усилению инфракрасных полос поглощения ионов CO_3^{2-} и NO_3^- , концентрация OH^- при этом колеблется около $3 \cdot 10^{-3}$ мол.%. Поскольку пик ТЛ при 98° К наблюдается только в кристаллах, выращенных на воздухе, естественно приписать его присутствию кислородосодержащих анионов. Действительно, с увеличением интенсивности инфракрасных полос поглощения ионов NO_3^- и особенно CO_3^{2-} его интенсивность растет. Неглубокие электронные ловушки, ответственные за этот пик, быстро заполняются: увеличение времени облучения сверх 5—10 мин. уже не приводит к дальнейшему запасанию светосуммы на этих уровнях. Подобным образом ведет себя электронный пик ТЛ при 115° К, связанный нами [7] с присутствием ионов натрия.

В области низких температур следует ожидать появления дырочных пиков ТЛ, обусловленных термическим разрушением v_k^- , v_{ka}^- и, возможно, V_1 -центров. Так, в KJ-Tl v_k -пик имеет $T_m = 110$ ° К [3]; его интенсивность со временем облучения увеличивается, поэтому электронные пики ТЛ при 98 и 115° К в KJ-Tl (Кироп.) наблюдаются только при малых дозах облучения ($t < 10$ мин.). Активаторная люминесценция ($\lambda_m = 430$ нм) возникает в результате рекомбинации подвижных дырок с Tl³⁺-центрами. В фосфоре KJ-Cu (Стокб.), который плохо окрашивается рентгеновскими лучами при 90° К, v_k -пик ТСЛ имеет небольшую интенсивность.

В кристаллах KJ (Кироп.) в отличие от KJ (Стокб.) при 90° К эффективно образуются F -, α -, V_2 - и V_1 -центры окраски. Концентрация v_k -центров после прекращения рентгенализации, по-видимому, невелика, так как по спектрам оптического поглощения они не могут быть обнаружены. Это обстоятельство и наличие в области низких температур электронных пиков ТЛ не позволило точно установить максимум ТЛ, обусловленный термическим разрушением v_k -центров. Однако появление в спектрах ТЛ α -люминесценции в области 90—120° К свидетельствует о протекании наряду с электронными и дырочными процессами: как известно [8], излучение α -центров возникает в результате туннельной рекомбинации $[v_k + F]$ -пар.

Максимум термовысвечивания при 154° К обусловлен термическим разрушением F' -центров [9] и рекомбинацией освобожденных электронов с v_{ka} -центрами и активаторными дырочными центрами. Примешивание к «синей» люминесценции, характерной для свечения ионов натрия, зеленого излучения в KJ, KJ-Na и KJ-OH, очевидно, обязано туннельной рекомбинации пар $[v_{ka} + FI]$, поскольку v_{ka} -центры термически подвижны в этой области температур. Заметим, что в фосфоре KJ-Ag (1 · 10⁻² мол.% Ag⁺) наблюдается дырочный пик ТЛ с $T_m = 160$ ° К, в котором зеленая активаторная люминесценция появляется в результате туннельной рекомбинации пар $[v_{ka} + AgI]$ [10].

Ранее нами было установлено, что после прогрева до 190—200° К термически разрушаются V_1 -центры [9]. Исчезновение V_1 -центров сопровождается уменьшением концентрации F - и α -центров. Так как V_1 -центр представляет собой междоузельный атом галоида, стабилизированный ионом натрия, очевидно, что рекомбинация его с F -центром приведет к восстановлению решетки. Рекомбинация междоузельного атома с α -центром должна сопровождаться образованием v_k -центра, который в свою очередь может рекомбинировать с F -центром либо с атомарным активаторным центром. Действительно, в спектрах ТЛ кристаллов KJ, KJ-Na и KJ-OH при температурах выше 170° К как и в спектрах РЛ, наблюдается α -люминесценция. С термическим разрушением V_1 -центров в этих кристаллах можно связать довольно слабый широкий пик ТЛ при 190° К, интенсивность которого растет при увеличении содержания натрия. После термического разрушения V_1 -центров в фосфоре KJ-Cu наблюдается усиление

активаторной фотостимулированной люминесценции (ФСЛ), что подтверждает образование v_k -центров в результате рекомбинации V_1^- и α -центров. Увеличение стимулированной F -светом люминесценции обусловлено ростом концентрации Cu^{2+} -ионов в результате делокализации v_k -центров на ионах меди.

С разрушением атомарных активаторных центров захвата связаны максимумы термовысвечивания при $175^\circ K$ в КJ-Tl [3] и при $230^\circ K$ в КJ-Cu [7]. Было обнаружено, что увеличение концентрации таллия приводит к появлению дополнительных электронных максимумов ТЛ при 240 и $260^\circ K$, причем интенсивность первого с увеличением содержания Tl^+ растет более чем линейно. Известно, что при высоких концентрациях таллия в кристаллах КJ образуются парные активаторные центры [11],

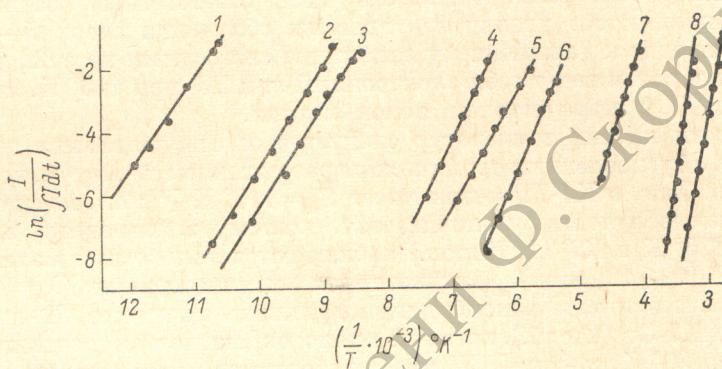


Рис. 1. Зависимость $\ln \left(\frac{I}{Jdt} \right)$ от обратной температуры.

1 и 3 — пики ТЛ при 98 и $115^\circ K$ в КJ-KOH (1 вес. % KOH); 2, 5 и 7 — пики ТЛ 110 , 175 и $240^\circ K$ в КJ-Tl (0.01 мол. % Tl^+); 4 и 8 — пики ТЛ при 154 и $310^\circ K$ в КJ-Cu ($4 \cdot 10^{-3}$ мол. % Cu^{2+}); 6 — пик ТЛ при $190^\circ K$ в КJ-Na (0.13 мол. % Na^+); 9 — пик ТЛ при $360^\circ K$ в КJ (Харшай).

которые способны локализовать электроны [12]. На этом основании естественно пик ТЛ при $240^\circ K$ связать с термическим разрушением Tl^+ -центров.

В нижней строке табл. 2 приводятся данные о знаке максимумов ТЛ и о связи их с термическим разрушением соответствующих центров окраски. В предпоследней строке указаны энергии активации пиков ТЛ, определенные по методу Антонова-Романовского [13]. Элементарность пиков достигалась различными способами: выдерживанием кристаллов при определенной температуре до полного затухания фосфоресценции, прогревом до различных температур с последующим охлаждением, возбуждением образцов при высокой температуре и освещением F -светом при низкой, а также рентгенизацией кристалла при температуре на $5-10$ градусов ниже соответствующего максимума ТЛ. В большинстве случаев в согласии с авторами [4] кинетика ТЛ получилась мономолекулярной (рис. 1).

Перейдем к обсуждению природы высокотемпературных максимумов ТЛ. Для получения достаточной интенсивности этих пиков исследуемые кристаллы облучались рентгеновскими лучами при $130^\circ K$, т. е. в области оптимального создания центров окраски.

В образце КJ фирмы Харшай¹ наблюдается интенсивный пик ТЛ с $T_m = 360^\circ K$, излучение в котором имеет максимум при 540 нм. В активированных таллием и медью кристаллах КJ к α -люминесценции (540 нм) в этом пике ТЛ примешивается активаторное свечение и зеленое излучение с $\lambda_m = 510$ нм. Поскольку в данной области температур происходит термическое разрушение F - и V_2 -центров, естественно предположить, что появление α -люминесценции обусловлено рекомбинацией F - и V_2 -центров. Меха-

¹ Низкотемпературная ТЛ КJ (Харшай) на один—два порядка слабее по сравнению с другими «чистыми» КJ.

низм появления активаторного излучения в области разрушения F - и V_2 -центров не совсем понятен, поскольку дырочные активаторные центры термически разрушаются при более низкой температуре. Очевидно, что этот механизм одинаков с механизмом высокотемпературной РЛ, сущность которого в настоящее время не установлена.

Кроме того, в кристаллах КJ-Tl и КJ-Cu наблюдаются пики ТЛ при 295 и 310° К, причем с увеличением времени облучения первый подавляется максимумом ТЛ при 310° К. Определить знак ТЛ в этих пиках методом, применяемым к низкотемпературным пикам,² нельзя, поскольку при $T > 270$ ° К происходит температурное тушение РЛ и ФСЛ, обусловленное отходом дырок от A^{2+} -центров (рис. 2, кривые 1 и 2). Появление пика ТЛ в области термического разрушения Tl^{2+} -центров в фосфоре КJ-Tl, по предположению Плявинь [14], обусловлено туннельной рекомбинацией парно расположенных F - и Tl^{2+} -центров. Отсутствие α -люминесценции объясняется тем, что энергия рекомбинации передается на «свой» Tl^{+} -центр.

В спектрах ТЛ фосфоров КJ-Tl и КJ-Cu в области пика ТЛ при 310° К активаторная люминесценция преобладает. При высокой концентрации F -центров наряду с активаторной появляется α -люминесценция. Мы полагаем, что действительно пик ТЛ при 310° К в указанных фосфорах обусловлен термическим разрушением A^{2+} -центров и туннельной рекомбинацией освобожденной дырки с F -центром. Образовавшийся экзитон может аннигилировать, возбудив α -центр или соседний Tl^{+} -ион. Для подтверждения высказанного предположения были исследованы кристаллы КJ-Tl и КJ-Cu, содержащие сложные активаторные центры, люминесцирующие в зеленой области спектра [15-17]. Оказалось, что для излучения с $\lambda_m = 500 - 520$ нм ФСЛ затухает при более высоких температурах, чем для основных центров свечения и соответственно появляются дополнительные пики ТЛ при 340° К в КJ-Cu и 370° К в КJ-Tl. Эти данные для фосфора КJ-Cu представлены на рис. 2.

На основании изложенного материала можно сделать вывод, что рекомбинационная термостимулированная люминесценция в фосфорах на основе КJ обусловлена термическим разрушением примесных центров захвата электронов и дырок; исключение составляют пики ТЛ, связанные с термическим разрушением v_k^- , F' - и $[F + V_2]$ -центров.

В заключение хочется отметить, что поскольку метод термовысвечивания относительно прост и обладает высокой чувствительностью, приведенные экспериментальные данные могут быть использованы для качественного анализа кристаллов КJ на содержание в них примесей кислородосодержащих анионов, натрия, меди, таллия.

Литература

- [1] A. B. Smaller, E. Avogu. Phys. Rev., 92, 232, 1953.
- [2] A. A. Bgainger, M. Israeli. Phys. Rev., 132, 2501, 1963.
- [3] H. Hersh. J. Chem. Phys., 31, 909, 1959.
- [4] P. A. Kink, G. G. Laidja. Tr. IFIA AN ЭССР, № 31, 142, 1966.

² Облучение F -светом кристалла при 90° К после предварительной рентгенации при более высокой температуре.

- [5] М. Р. Закис. Сб. «Проблемы чистоты и совершенства ионных кристаллов», 28. Тарту, 1969.
- [6] Т. Timusk. Bull. Amer. Phys. Soc., 7, 38, 1962.
- [7] Л. П. Смольская. Изв. АН СССР, сер. физ., 33, 1029, 1969.
- [8] Я. Р. Боган. Автореф. канд. дисс., Рига, 1969.
- [9] Л. П. Смольская, Л. А. Макарова. Матер. VIII физ. научн. конф., 270. Хабаровск, 1971.
- [10] Б. Д. Лобанов, Э. Э. Пензина, И. А. Парфианович. Опт. и спектр., 34, 515, 1973.
- [11] Р. Н. Yuster, C. J. Delbecq. J. Chem. Phys., 21, 892, 1953.
- [12] C. J. Delbecq, A. K. Ghosh, P. H. Yuster. Phys. Rev., 154, 797, 1967.
- [13] В. В. Антонов-Романовский. Изв. АН СССР, сер. физ., 10, 477, 1946.
- [14] I. K. Plavin, G. K. Vale, L. E. Nagli, R. A. Kalnin. Color—Centers in ionic crystals. Internat. conf., England № 91, 1971.
- [15] T. Tsubai, R. Kato. J. Phys. Soc. Japan, 24, 427, 1968.
- [16] Л. П. Смольская, И. А. Парфианович, Е. И. Шуралева, Л. В. Морожникова. Матер. VIII физ. научн. конф., 263. Хабаровск, 1971.
- [17] И. А. Парфианович, Е. И. Шуралева, Л. П. Смольская, Л. А. Коженкова. Изв. вузов, физика, 4, 151, 1968.

Поступило в Редакцию 20 июля 1971 г.